

Винахід належить до способу отримання полікристалічного блока галогеніду формули  $A_eLn_1X_{(3f+e)}$ ; в якій Ln означає один або більше рідкісноземельних металів, X означає один або більше атомів галогену, вибраних з Cl, Br або I, і A означає один або більше лужних металів, таких як K, Li, Na, Rb або Cs, e, яке може дорівнювати нулю, становить менше або дорівнює 3f, і f більше або дорівнює 1, що має низький вміст води і оксигалогеніду, що включає стадію нагрівання суміші, що має, з одного боку, щонайменше одну сполуку з щонайменше одним Ln-X зв'язком і, з іншого боку, достатню кількість  $NH_4X$  для того, щоб отримати бажаний вміст оксигалогеніду, причому згадана стадія нагрівання приводить до розплавленої маси, що містить галогенід рідкісноземельного металу, де за згаданою стадією нагрівання настає стадія охолодження, і на стадії нагрівання після досягнення 300 °C температура не знижується нижче 200 °C до того, як отримана розплавлена маса. З блоків, одержаних указаним вище способом, можна виростити дуже чисті монокристали, що мають чудові скінтіляційні властивості.